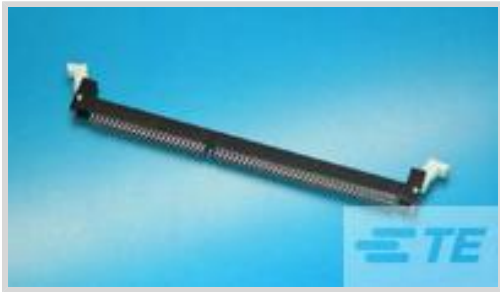




连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽 > DDR3 DIMM Sockets



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

连接器系统: 板对板

位数: 240

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

模块方向: 垂直

[所有 DDR3 DIMM Sockets \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3
连接器系统	板对板

结构特性

位数	240
模块方向	垂直

主体特性

弹射器类型	标准
-------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.75 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性



中心线（间距）	1 mm[.039 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	1.9 mm[.075 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DDR3 DIMM](#)



该系列中的其他产品 | [DDR3 SO DIMM](#)



客户还购买了





文档

产品图纸

VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1932000-8_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1932000-8_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1932000-8_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6-1773457-3_DDR3_DIMM_SOCKETS

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本